

有機EL素子Alq3層/発光層界面の評価

TOF-SIMS深さ方向分析による劣化評価

測定法 : TOF-SIMS・雰囲気制御下での処理
 製品分野 : ディスプレイ
 分析目的 : 組成分布評価

概要

輝度が劣化した素子の有機層を大気に曝さずに前処理から深さ方向分析までを行った結果、通電後のサンプルではAlq3/発光層界面に拡散が見られました。
 Slope Mapping(図1)およびイオンパッタを利用した深さ方向分析(図2)の両方で同様の結果が得られています。

データ

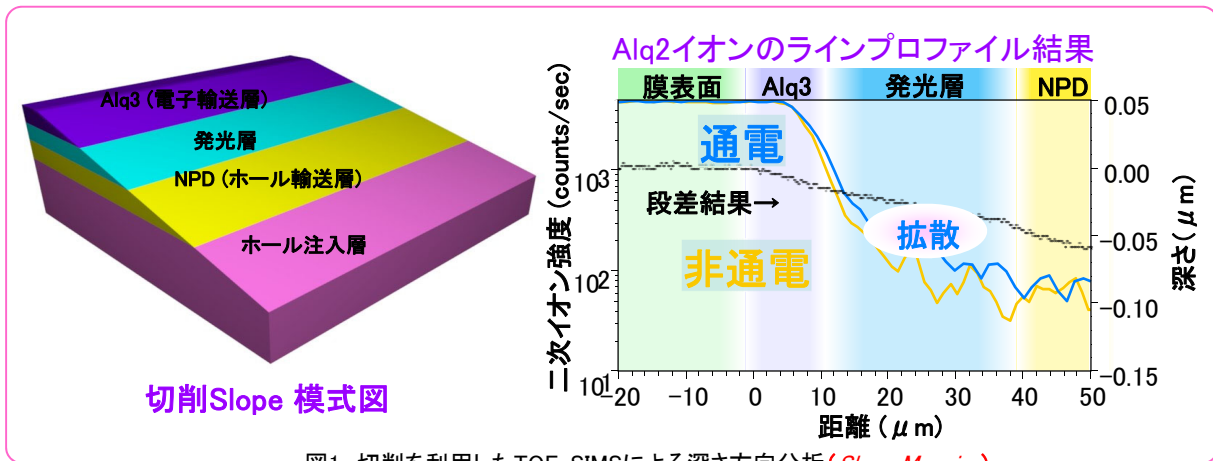


図1 切削を利用したTOF-SIMSによる深さ方向分析 (Slope Mapping)

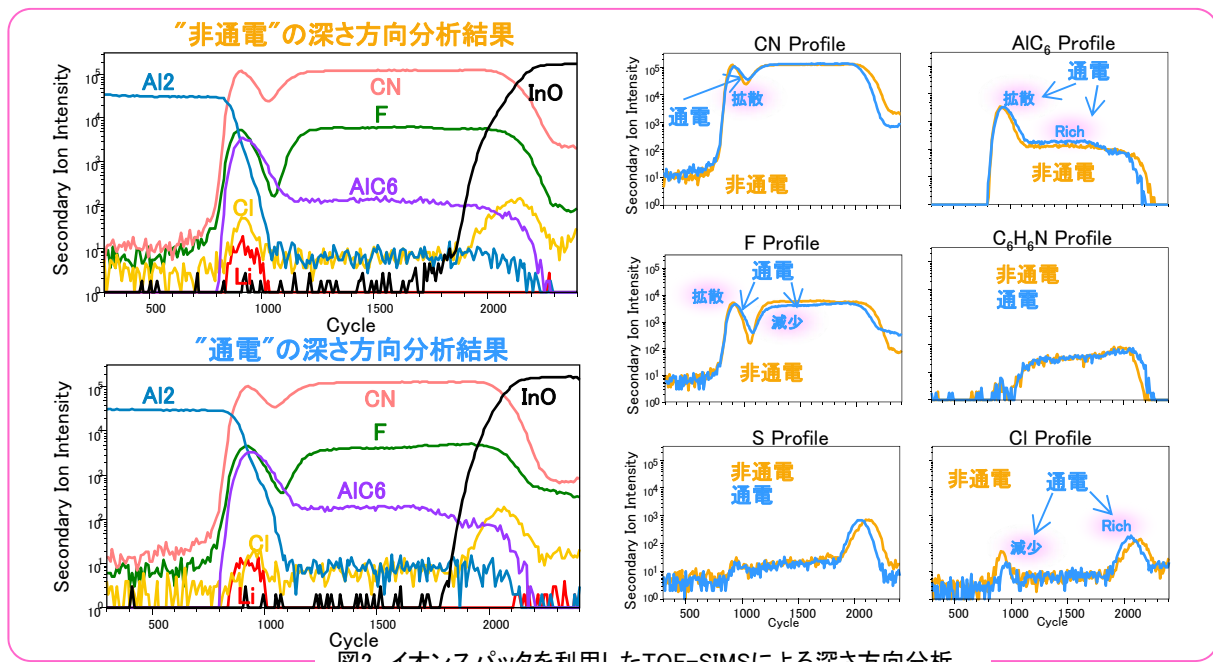


図2 イオンパッタを利用したTOF-SIMSによる深さ方向分析

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！